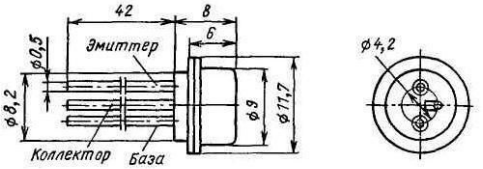


2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, 2Т603Е, 2Т603З, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603Д, 2Т603Е, 2Т603З, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603Д, 2Т603Е, 2Т603З

Предельные эксплуатационные данные

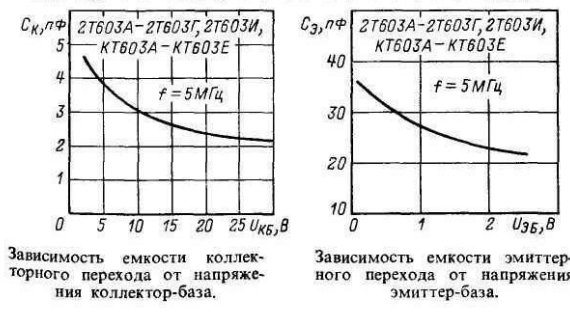
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные
 Предназначены для применения в импульсных и переключа-
 тельных высокочастотных схемах
 Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выво-
 дам. Обозначение типа приводится на корпусе.
 Масса транзистора не более 1,75 г.



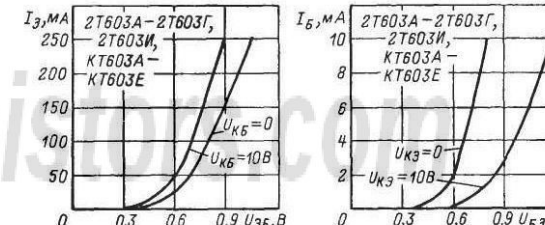
Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	
при $I_K = 150 \text{ мА}$, $I_B = 15 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более	0,8 В
типичное значение	0,2* В
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более	1,0 В
при $I_K = 350 \text{ мА}$, $I_B = 50 \text{ мА}$ 2Т603И не более	1,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер:	
при $I_K = 150 \text{ мА}$, $I_B = 15 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более	1,5 В
типичное значение	0,9* В
при $I_K = 350 \text{ мА}$, $I_B = 50 \text{ мА}$ 2Т603И не более	1,3 В
типичное значение	1,0* В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2 \text{ В}$	
при $T = 298 \text{ К}$:	
при $I_3 = 150 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603В, КТ603Д	20 – 80
КТ603А, КТ603В	10 – 80
2Т603Б, 2Т603Г	60 – 180
КТ603Б, КТ603Г не менее	60
КТ603Е	60 – 200
при $I_3 = 350 \text{ мА}$ 2Т603И не менее	20
типичное значение	50*
при $T = 213 \text{ К}$, $I_3 = 150 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603В	8 – 80
2Т603Б, 2Т603Г	20 – 180
2Т603И не менее	8
при $T = 398 \text{ К}$, $I_3 = 150 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603В	20 – 180
2Т603Б, 2Т603Г	60 – 400
2Т603И не менее	20
Время релаксации при $I_K = 150 \text{ мА}$, $I_B = 15 \text{ мА}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не более	70 нс
типичное значение	40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более	100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 30 \text{ мА}$, $f = 5 \text{ МГц}$ не более	
типичное значение	400 пс
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не более	25* пс
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 30 \text{ мА}$ не менее	
типичное значение	200 МГц
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	370* МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $f = 5 \text{ МГц}$ не более	
типичное значение	15 пФ
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5 \text{ МГц}$ не более	
типичное значение	40 пФ
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	35* пФ
Обратный ток коллектора, не более	
при $T = 298 \text{ К}$ при $U_{КБ} = 30 \text{ В}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 мкА
КТ603А, КТ603Б	10 мкА
при $U_{КБ} = 15 \text{ В}$:	
2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
КТ603В, КТ603Г	5 мкА
при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$ КТ603Д, КТ603Е	1 мкА
при $T = 398 \text{ К}$:	
при $U_{КБ} = 24 \text{ В}$ 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	60 мкА
при $U_{КБ} = 12 \text{ В}$ 2Т603В, 2Т603Г	60 мкА
Обратный ток эмиттера не более	
при $U_{ЭБ} = 3 \text{ В}$ 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	3 мкА
при $U_{ЭБ} = 4 \text{ В}$ 2Т603И	3 мкА

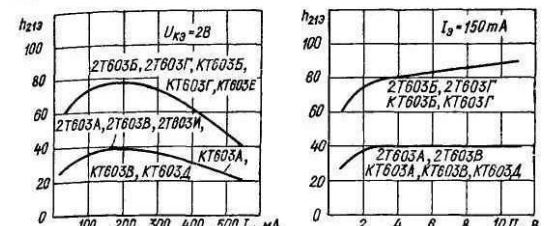
Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1 \text{ кОм}$	
при $T_n \leq 343 \text{ К}$:	
КТ603А, КТ603Б	30 В
КТ603В, КТ603Г	15 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В
при $T_n \leq 373 \text{ К}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	30 В
2Т603В, 2Т603Г	15 В
при $T_n = 393 \text{ К}$:	
КТ603А, КТ603Б	15 В
КТ603В, КТ603Г	7,5 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В
при $T = 398 \text{ К}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	24 В
2Т603В, 2Т603Г	12 В
при $T = 423 \text{ К}$:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	18 В
2Т603В, 2Т603Г	9 В
Напряжение эмиттер-база:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г	3 В
2Т603И при $T_n \leq 343 \text{ К}$	4 В
2Т603И при $T_n = 398 \text{ К}$	3 В
Постоянный ток коллектора	
	300 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{\text{им}} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q > 10$	
	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T \leq 323 \text{ К}$	0,5 Вт
при $T = 358 \text{ К}$ КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398 \text{ К}$ 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	0,12 Вт
Температура перехода:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	423 К
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	393 К
Общее тепловое сопротивление	
	200 К/Вт
Температура окружающей среды:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И	От 213 до 398 К
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	От 233 до 358 К
Примечание. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода 3 мм.	
Не допускается пайка выводов на расстоянии менее 5 мм от корпуса. Пайку выводов следует производить не более 10 с при температуре не более 543 К с теплоотводом между корпусом и местом пайки.	
Запрещается кручение выводов вокруг осн.	



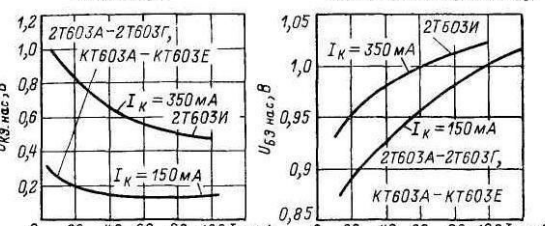
Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база. Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.



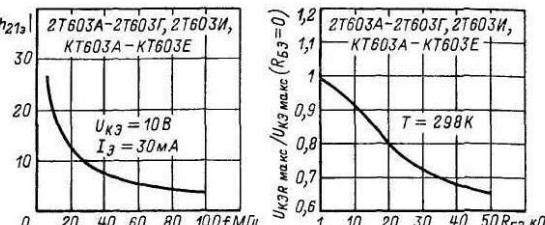
Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база. Входные характеристики.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы. Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты. Зависимость максимального допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.